

半導体における点欠陥と拡散-基礎と最先端デバイス-

[協賛予定] 応用物理学会, 電子情報通信学会, IEEE EDS, 日本鉄鋼協会, 日本材料学会, 日本MRS, 日本物理学会
LSI等のSi系素子, パワートランジスタや発光ダイオード等の化合物素子においては不純物の拡散制御や結晶欠陥密度の低減は素子特性の制御上, 非常に重要である. 本セミナーにおいては, 点欠陥, 拡散の基礎を学ぶと共に, 研究開発途上の実デバイスにおいてそれらの事象が如何ほど重要であるかについて明らかにする. 尚, 今回の企画は前年度に引き続きセミナー・シンポジウム委員会が主体となって提案するものである.

(企画世話人 兵庫県立大学 松尾直人, 大阪府立大学 沼倉 宏, 東京工業大学 小林能直)

日時 2015年11月12日(木) 9:30~17:10

場所 東京工業大学大岡山キャンパス 西9号館1階コラボレーションルーム
(アクセス: 東京急行大井町線/目黒線「大岡山駅」徒歩3分)

募集定員 50名

受講料

受講資格	事前申込	当日申込
正員	12,000	15,000
学生	5,000	6,000
非会員	15,000	20,000

(本会維持員会社社員、協賛学協会会員は会員扱い。学生は会員、非会員の区別なし)

申込要領 E-mailでmeeting@jim.or.jp宛お申し込み下さい。申込項目は以下のとおりです。

- ① 送信 subjectに「**セミナー：半導体における点欠陥と拡散-基礎と最先端デバイス-**」と記入、② 氏名・年齢、③ 会員・非会員・学生の区別(本会会員は会員番号も④ 勤務先・所属、⑤ 通信先住所(テキスト等送付先と電話番号) 申込受理確認のE-mailを返信します。

事前申込締切 2015年11月4日(水)着信

テキストの送付 開催10日前後までに発行送付の予定です。事前に申し込まれた方にはテキストが出来次第参加証等関係資料とともにお送りいたします。

受講料払込方法 お申込受理後、請求書を送付いたします。

問合せ 〒980-8544 仙台市青葉区一番町1-14-32 フライハイトビル2階

(公社)日本金属学会 セミナー参加係

E-mail: meeting@jim.or.jp TEL 022-223-3685 FAX 022-223-6312

9:30~9:40	はじめに	セミナー・シンポジウム委員長/兵庫県立大学	松尾直人
9:40~10:40	点欠陥の物理	東北大学	米永一郎
10:40~11:40	拡散の基礎	慶応義塾大学	植松真司
11:40~13:00	昼食		
13:00~14:00	GaN系デバイスにおける結晶欠陥の影響	福井大学	塩島謙次
14:00~15:00	高性能Ge薄膜トランジスタの現状と展望	東芝/産総研	臼田宏治
15:00~15:10	休憩		
15:10~16:10	クラスターイオンビームナノ加工の現状と展望	兵庫県立大学	豊田紀章
16:10~17:10	軟X線照射ドーピングの現状と展望	兵庫県立大学	部家 彰